Docket No.: M1071.1886

(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Masahiro Kubota

Application No.: Not Yet Assigned

Confirmation No.:

Filed: Concurrently Herewith

Art Unit: N/A

For: PHOTOREACTIVE RESIN COMPOSITION,

METHOD FOR MAKING CIRCUIT SUBSTRATE USING SAME, AND METHOD FOR MAKING CERAMIC MULTILAYER SUBSTRATE USING

SAME

Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

MS Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

Country Application No. Date
Japan 2003-033856 February 12, 2003

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: January 6, 2004

Respectfully submitted,

Edward A. Meilman

Registration No.: 24,735

DICKSTEIN SHAPIRO MORIN &

OSHINSKY LLP

1177 Avenue of the Americas, 41st Floor

New York, New York 10036-2714

(212) 835-1400



日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 2月12日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-033856

[ST. 10/C]:

[JP2003-033856]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社村田製作所

 $\overline{}$

2003年12月16日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康





【書類名】

特許願

【整理番号】

32-0835

【提出日】

平成15年 2月12日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G03F 7/027

H05K 3/46

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

久保田 正博

【特許出願人】

【識別番号】

000006231

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

【氏名又は名称】

株式会社村田製作所

【代表者】

村田 泰隆

【電話番号】

075-955-6731

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

005304

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



【書類名】

明細書

【発明の名称】 光反応性樹脂組成物、回路基板の製造方法、およびセ

ラミック多層基板の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

- (a) 卑金属粉末、
- (b) 有機バインダ、
- (c)感光性有機成分、
- (d) 分子量が1500以下のポリカルボン酸系分散剤、

を含有することを特徴とする光反応性樹脂組成物。

【請求項2】 前記有機バインダの分子量が10000以上であることを特 徴とする、請求項1に記載の光反応性樹脂組成物。

【請求項3】 前記卑金属粉末100重量部に対して、前記ポリカルボン酸 系分散剤を0.05~0.8重量部含有することを特徴とする、請求項1または 請求項2に記載の光反応性樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれかに記載の光反応性樹脂組成 物を用いて導体パターンを形成する工程を備えることを特徴とする回路基板の製 造方法。

【請求項5】 請求項1から請求項3のいずれかに記載の光反応性樹脂組成 物を支持体上に塗布する工程と、

前記光反応性樹脂組成物を露光、現像して前記支持体上に所定の導体パターン を形成する工程と、

前記支持体上に形成された前記導体パターンを基板上に転写する工程と、 前記導体パターンを焼成する工程と、

を備えることを特徴とする回路基板の製造方法。

【請求項6】 請求項1から請求項3のいずれかに記載の光反応性樹脂組成 物を支持体上に塗布する工程と、

前記光反応性樹脂組成物を露光、現像して前記支持体上に所定の導体パターン を形成する工程と、



前記支持体上に形成された前記導体パターンをセラミックグリーンシート上に 転写する工程と、

前記導体パターンが転写されたセラミックグリーンシートを積層して積層体を 形成する工程と、

前記積層体を焼成する工程と、

を備えることを特徴とするセラミック多層基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、導体パターン形成用の光反応性樹脂組成物に関し、それを用いて導体パターンを形成する回路基板の製造方法、およびセラミック多層基板の製造方法に関する。

[0002]

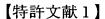
【従来の技術】

近年、移動体通信機器、衛星放送受信機器、コンピュータなどに用いられる高 周波電子部品は、小型かつ高性能であることが強く求められている。また、高周 波電子部品の配線パターンに関しても、その高密度化および信号の高速化への対 応が要求されており、その高密度化や信号の高速化を達成するためには、配線パ ターンの微細化および厚膜化が必要である。

[0003]

このように微細かつ厚膜の配線パターンを形成するためには、光反応性樹脂組成物を用いたフォトリソグラフィ法が有効である。これは、無機粉末(配線パターン形成には導電性金属粉末、ビアホール形成にはガラス粉末)に、アルカリ可溶性ポリマー、エチレン性不飽和2重結合を有するモノマー、光反応開始剤などからなる光反応性有機成分を含有させた光反応性樹脂組成物を基板上に塗布し、乾燥後、マスクを当接し、露光後、アルカリ現像液で現像してパターニング後、焼成して所定形状の配線パターンを形成するというものである。(例えば、特許文献1参照。)

[0004]



特開平5-67405号公報

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、このような光反応性樹脂組成物を露光、現像する際には、異物が基板上に残留する現像残渣が問題となる。特に、光反応性樹脂組成物に卑金属粉末が含有されている場合、卑金属粉末の凝集による現像残渣を防止できないという問題があった。

[0006]

本発明は、卑金属粉末の凝集が起こりにくい光反応性樹脂組成物を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る光反応性樹脂組成物は、(a) 卑金属粉末、(b) 有機バインダ 、(c) 感光性有機成分、(d) 分子量が1500以下のポリカルボン酸系分散 剤、を含有することを特徴とする。

[0008]

前記光反応性樹脂組成物においては、前記有機バインダの分子量が10000 以上であることが好ましい。また、前記光反応性樹脂組成物は、前記卑金属粉末 100重量部に対して、前記ポリカルボン酸系分散剤を0.05~0.8重量部 含有することが好ましい。

[0009]

本発明に係る回路基板の製造方法は、前記光反応性樹脂組成物を用いて導体パターンを形成する工程を備えることを特徴とする。

[0010]

また、本発明に係る回路基板の製造方法は、前記光反応性樹脂組成物を支持体上に塗布する工程と、前記光反応性樹脂組成物を露光、現像して前記支持体上に所定の導体パターンを形成する工程と、前記支持体上に形成された前記導体パターンを基板上に転写する工程と、前記導体パターンを焼成する工程と、を備える



ことを特徴とする。

[0011]

本発明に係るセラミック多層基板の製造方法は、前記光反応性樹脂組成物を支持体上に塗布する工程と、前記光反応性樹脂組成物を露光、現像して前記支持体上に所定の導体パターンを形成する工程と、前記支持体上に形成された前記導体パターンをセラミックグリーンシート上に転写する工程と、前記導体パターンが転写されたセラミックグリーンシートを積層して積層体を形成する工程と、前記積層体を焼成する工程と、を備えることを特徴とする。

[0012]

【発明の実施の形態】

<実施形態1>

以下、本発明に係る光反応性樹脂組成物を構成する(a)~(d)の成分について、それぞれ説明する。

[0013]

(a) 卑金属粉末

卑金属粉末としては、Cu, Mo, Ni, Wおよびそれらの少なくとも1種を含有する合金を用いることができる。また、卑金属粉末は球状であることが好ましく、平均粒径 d_{50} が $1~\mu$ $m\sim 5~\mu$ m、比表面積が 0. $1\sim 2$. $0~m^2/g$ であることが好ましい。このような条件において、特に導体パターンを形成しやすくなる。

[0014]

また、卑金属粉末は表面が酸化処理されたものを用いてもよい。卑金属粉末の表面を酸化する方法としては、卑金属粉末を酸素含有雰囲気中で室温以上の温度に加熱する方法が挙げられる。この方法では、卑金属粉末表面の卑金属酸化物の状態を制御しやすく、卑金属粉末の表面に緻密な卑金属酸化物膜を形成することができる。

[0015]

(b) 有機バインダ

光反応性樹脂組成物は、環境への配慮から、水もしくはアルカリ水溶液による



現像が可能であることが好ましい。このため、有機バインダは、プロトンを遊離 する性質のある酸性官能基を有することが好ましい。有機バインダとしては、例 えば、カルボキシル基を有するアクリル系共重合体などを用いることができる。

[0016]

なお、カルボキシル基を有するアクリル系共重合体は、例えば、不飽和カルボン酸とエチレン性不飽和化合物を共重合させることにより製造することができる。不飽和カルボン酸としては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸及びこれらの無水物などが挙げられる。一方、エチレン性不飽和化合物としては、アクリル酸メチル、アクリル酸エチルなどのアクリル酸エステル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチルなどのメタクリル酸エステル、フマル酸モノエチルなどのフマル酸エステルなどが挙げられる。

[0017]

また、アクリル系共重合体としては、以下のような形態の不飽和結合を導入した物を用いてもよい。

[0018]

1) 前記アクリル系共重合体の側鎖のカルボキシル基に、これと反応可能な、エポキシ基などの官能基を有するアクリル系モノマーを付加したもの。

[0019]

2)側鎖のカルボキシル基の代わりにエポキシ基が導入されてなる前記アクリル系共重合体に、不飽和モノカルボン酸を反応させた後、さらに飽和または不飽和多価カルボン酸無水物を導入したもの。

[0020]

また、有機バインダの分子量は10000以上であることが好ましい。分子量が10000未満であると、光硬化反応が不十分となり、現像時に導体パターンが流出したり、露光部の現像除去性が高くなってパターンの一部が剥離し、パターンの欠けが発生することがある。

[0021]

また、有機バインダの分子量は60000以下であることが好ましい。分子量が6000を超えると、有機バインダと卑金属粉末が反応して生じるゲル化物



が巨大になりやすくなり、組成物全体が素早くゲル化することがある。

[0022]

(c) 感光性有機成分

感光性有機成分は、従来から公知の光重合性、もしくは光変性化合物のことであって、例えば、

- 1) 不飽和基などの反応性官能基を有するモノマーやオリゴマーと、芳香族カルボニル化合物などの光ラジカル発生剤の混合物、
- 2) 芳香族ビスアジドとホルムアルデヒドの縮合体などのいわゆるジアゾ樹脂
- 3) エポキシ化合物などの付加重合性化合物とジアリルヨウドニウム塩などの 光酸発生剤の混合物、
 - 4) ナフトキノンジアジド系化合物、

などが挙げられる。

[0023]

これらの感光性有機成分のうち、特に好ましいのは、不飽和基などの反応性官能基を有するモノマーやオリゴマーと、芳香族カルボニル化合物などの光ラジカル発生剤との混合物である。

[0024]

上記光ラジカル発生剤としては、ベンジル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、ベンゾイル安息香酸メチル、4 ーベンゾイルー4 ーメチルジフェニルサルファイド、ベンジルジメチルケタール、2 ーn ーブトキシー 4 ージメチルアミノベンゾエート、2 ークロロチオキサントン、2 、4 ージエチルチオキサントン、2 、4 ージイソプロピルチオキサントン、4 ソプロピルチオキサントン、4 ージメチルアミノエチルベンゾエート、4 ージメチルアミノ安息香酸エチル、4 ージメチルアミノ安息香酸イソアミル、4 ・ 4

7/



ェニルケトン、2-ビドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、2, 2-ジメトキシ-1、2-ジフェニルエタン-1-オン、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-ビドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、1- [4-(2-ビドロキシエトキシ) -フェニル]-2-ビドロキシ-2-メチル-1-プロパン-1-オン、2-メチル-1- [4-(メチルチオ) フェニル]-2-モルフォリノプロパン-1-オン、メチルベンゾイルフォルメート、1-フェニル-1, 2-プロパンジオン-2-(0-エトキシカルボニル) オキシム、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル) -1-ブタノン、ビス(2, 6-ジメトキシベンゾイル)-2, 4, 4-トリメチルペンチルフォスフィンオキサイド、ビス(2, 4, 6-トリメチルベンゾイル) フェニルフォスフィンオキサイドなどが挙げられる。

[0025]

また、上記反応性官能基含有モノマーおよびオリゴマーとしては、ヘキサンジ オールトリアクリレート、トリプロピレングリコールトリアクリレート、トリメ チロールプロパントリアクリレート、ステアリルアクリレート、テトラヒドロフ ルフリルアクリレート、ラウリルアクリレート、2-フェノキシエチルアクリレ ート、イソデシルアクリレート、イソオクチルアクリレート、トリデシルアクリ レート、カプロラクトンアクリレート、エトキシ化ノニルフェノールアクリレー ト、1, 3-ブタンジオールジアクリレート、1, 4-ブタンジオールジアクリ レート、ジエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジア クリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、エトキシ化ビスフェノー ルAジアクリレート、プロポキシ化ネオペンチルグリコールジアクリレート、ト リス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレートトレアクリレート、エトキシ化 トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレ ート、プロポキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート、プロポキシ化グ リセリルトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジトリ メチロールプロパンテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールヒドロキシペ ンタアクリレート、エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート、テト ラヒドロフルフリルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、イソデシ

8/



ルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、1,4ーブタンジオールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、1,6ーへキサンジオールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、1,3ーブチレングリコールジメタクリレート、エトキシ化ビスフェノールAジメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレートなどが挙げられる。

[0026]

(d) ポリカルボン酸系分散剤

ポリカルボン酸系分散剤は、卑金属粉末の凝集を抑制する作用を有する。これは、ポリカルボン酸系分散剤が卑金属粉末と反応しやすく、卑金属粉末の表面を十分にコーティングするためと推測される。したがって、本発明に係る光反応性 樹脂組成物においては、現像残渣が発生しにくくなるため、安定して微細かつ厚 膜のパターンを形成することができる。

[0027]

ポリカルボン酸系分散剤の分子量は1500以下である。これを超えると、卑金属の凝集を抑制する作用が弱くなるため好ましくない。なお、分子量1500以下という定義から明らかなように、ポリカルボン酸系分散剤は、ポリカルボン酸系有機バインダとは区別されるものである。

[0028]

また、ポリカルボン酸系分散剤は、卑金属粉末100重量部に対して、0.05~0.8重量部含有されていることが好ましい。ポリカルボン酸系分散剤の含有量が0.05重量部未満の場合、卑金属粉末の凝集を抑制する作用が弱くなり、0.8重量部を超えると、露光部の現像除去性が高くなってパターンの一部が剥離し、パターンの欠けが発生することがある。

[0029]

(e) その他の成分

本発明に係る光反応性樹脂組成物においては、さらに紫外線吸収剤が含有されていることが望ましい。これにより、光散乱による露光不良を抑制することがで

9/



きる。紫外線吸収剤としては、アゾ系赤色顔料、アミン系赤色染料などが挙げられる。

[0030]

また、本発明に係る光反応性樹脂組成物においては、さらにガラス粉末やセラミック粉末などの無機粉末が含有されていてもよい。これにより、基板との密着性を向上させることができる。ガラス粉末としては、ホウケイ酸系ガラスなどの公知のガラス粉末を用いることができる。また、セラミック粉末としては、アルミナやジルコニアなどをはじめ、結晶化ガラス系セラミック、ガラス複合系セラミック、非ガラス系セラミックなどの公知の低温焼結セラミック粉末を用いることができる。

[0031]

さらに、本発明に係る光反応性樹脂組成物においては、必要に応じて、重合禁止剤などの保存安定剤、酸化防止剤、染料、顔料、消泡剤、界面活性剤などが含有されていてもよい。

[0032]

<実施形態2>

以下、本発明に係る光反応性樹脂組成物を用いた回路基板の製造方法について、 、その一実施形態を説明する。

[0033]

まず、図1 (a) に示すように、基板11の一方主面上に、本発明に係る光反 応性樹脂組成物12を塗布する。基板11としては、例えば、アルミナ基板など を用いることができる。また、光反応性樹脂組成物12を塗布する手段としては、例えば、スクリーン印刷やスピンコーターなどを用いることができる。

[0034]

次に、図1(b)に示すように、光反応性樹脂組成物12上に所定形状のフォトマスク13を当接させ、露光する。露光手段としては、例えば、高圧水銀灯やメタルハライドランプなどを用いることができる。

[0035]

次に、図1 (c)に示すように、アルカリ水溶液により光反応性樹脂組成物 1



2を現像し、導体パターン14aをパターン化する。アルカリ水溶液としては、 例えば、炭酸ナトリウム水溶液やモノエタノールアミン水溶液、トリエタノール アミン水溶液などを用いることができる。

[0036]

次に、熱処理により、導体パターン14aに含まれる卑金属粉末を焼結させ、 図1(d)に示すように、基板11の一方主面上に配線導体14を形成する。以 上の工程を経て、回路基板10が作製される。

[0037]

<実施形態3>

以下、本発明に係る光反応性樹脂組成物を用いた回路基板の製造方法について、その他の実施形態を説明する。

[0038]

まず、図2(a)に示すように、支持体25上に本発明に係る光反応性樹脂組成物22を塗布する。支持体25としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PEN)フィルムなどを用いることができる。

[0039]

次に、図2(b)に示すように、光反応性樹脂組成物22上に所定形状のフォトマスク23を当接させ、露光する。次に、図2(c)に示すように、アルカリ水溶液により光反応性樹脂組成物22を現像し、導体パターン24aを形成する。

$[0\ 0\ 4\ 0]$

次に、図2 (d) に示すように、基板21の一方主面と導体パターン24aとが接するようにして、基板21上に支持体25を配置し、圧着する。次に、基板21から支持体25を剥離し、図2(e)に示すように、基板21の一方主面上に導体パターン24aを転写する。

[0041]

次に、熱処理により、導体パターン24aに含まれる卑金属粉末を焼結させ、 図2(f)に示すように、基板21の一方主面上に配線導体24を形成する。以



上の工程を経て、回路基板 2 0 が作製される。なお、その他の構成や工程については、実施形態 2 と同様であるため説明を省略する。

[0042]

<実施形態4>

以下、本発明に係る光反応性樹脂組成物を用いたセラミック多層基板の製造方法について、その一実施形態を説明する。

[0043]

まず、図3(a)に示すように、実施形態3と同様にして、支持体35上に導体パターン34aを形成する。

[0044]

次に、図3(b)に示すように、セラミックグリーンシート36aの一方主面と導体パターン34aとが接するようにして、セラミックグリーンシート36a 上に支持体35を配置し、圧着する。次に、セラミックグリーンシート36aから支持体35を剥離し、図3(c)に示すように、セラミックグリーンシート36aの一方主面上に導体パターン34aを転写する。セラミックグリーンシート36aとしては、例えば、アルミナ粉末およびホウケイ酸ガラス粉末を有機ビヒクルに混合してなるセラミックスラリーを、シート状に成形したものを用いることができる。

[0045]

次に、図3(d)に示すように、導体パターン34aが転写されたセラミックグリーンシート36aを複数枚積層、圧着し、積層体30aが作製される。なお、一部のセラミックグリーンシート36aには厚み方向に貫通孔が形成され、その中にビア導体用の導電性ペースト38aが充填されている。次に、積層体30aを焼成し、図3(e)に示すように、複数のセラミック層36、配線導体34、およびビア導体38を備えるセラミック多層基板30が作製される。

[0046]

【実施例】

以下のようにして光反応性樹脂組成物を作製し、これを評価した。

1. 光反応性樹脂組成物の作製

本実施例において、光反応性樹脂組成物の作製に使用した各材料は、以下のものである。

[0047]

(a) 卑金属粉末

銅粉末: 銅粉末を空気中、200℃・70RH%下において放置し、表面を 酸化処理したもの。

酸素含有量 0.5 重量%、平均粒径 3 μm、球状。

(b) 有機バインダ

有機バインダ a 1:メタクリル酸/メタクリル酸メチルを共重合させた後、

メタクリル酸に対して 0. 2 倍モル量のエポキシシクロヘキシルメチルメタクリレートを付加反応させた、エチレン性不飽和 2 重結合含有アクリル系共重合体。

酸価=118。分子量Mw=19000。

有機バインダ a_2 : 有機バインダ a_1 と同じ。分子量 $M_W = 1 2 0 0 0$ 。 有機バインダ a_3 : 有機バインダ a_3 と同じ。分子量 $M_W = 7 0 0 0$ 。

(c) 感光性有機成分

モノマー:エトキシ変性トリメチロールプロパントリアクリレート

光ラジカル発生剤 a : 2-メチルー1- [4-(メチルチオ) -フェニル]-2 -モルフォリノプロパン-1 -オン

光ラジカル発生剤b:2,4-ジエチルチオキサントン

(d) 分散剤

分散剤 a_1 : フローレンG 6 0 0 (共栄社化学製、ポリカルボン酸系、 分子量 $M_W = 8$ 6 0)

分散剤 a_2 : フローレンG 7 0 0 (共栄社化学製、ポリカルボン酸系、 分子量 $M_W = 2 3 0$)

分散剤 a 3: フローレンG 8 2 0 (共栄社化学製、ポリカルボン酸系、 分子量Mw=1300)

分散剤 a $_4$: ディスパロン $_2$ 1 5 0 (楠本化成製、ポリカルボン酸系、 分子量 M_W = 1 6 0 0)

分散剤 a 5:ディスパロン1210 (楠本化成製、ポリカルボン酸系、

分子量M₩=1900)

分散剤b:ソルビタンラウレート

分散剤 c:ポリビニルピロリドン(K値=30)

(e) その他の成分

有機溶剤a:ジプロピレングリコールモノメチルエーテル

有機溶剤b:ペンタメチレングリコール

多価アルコール:グルシトール

紫外線吸収剤:アゾ系染料

チクソトロピック剤:ディスパロン3600N(楠本化成製、固形分濃度 50%)

ガラス粉末:S i O₂-B i ₂O₃-B₂O₃ガラス、平均粒径 3 μ m、球状。

[0048]

上記各材料を下記の表1、表2に示す重量比となるように、秤量、混合し、3本ロールミルによる混練を行い、光反応性樹脂組成物の試料1~18を作製した。

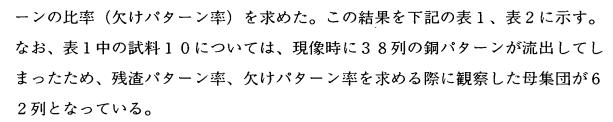
$[0\ 0\ 4\ 9]$

- 2. 光反応性樹脂組成物の評価
- (1) パターン精度の評価

上記光反応性樹脂組成物の試料 $1\sim18$ を、組成物作製 3 週間後に、それぞれ PETフィルム上にスクリーン印刷によって塗布し、1 時間乾燥して、 $10\,\mu$ m 厚の塗膜を形成した。次に、ライン幅 $20\,\mu$ m、ライン間隔 $20\,\mu$ mのパターンが描画されたフォトマスクを通して、高圧水銀灯から露光量 $200\,\mu$ m 0 万 0 位 大に、炭酸ナトリウム水溶液による現像処理を行い、P ETフィルム上にライン幅 $20\,\mu$ m、ライン間隔 $20\,\mu$ mの銅パターンを形成した。

[0050]

次に、このような銅パターンを合計 100列観察し、銅粉末の凝集物による現像残渣が残るパターンの比率(残渣パターン率)、一部が欠落してしまったパタ



[0051]

【表1】

		試料1	試料2	試料3	*試料4	*試料5	*試料6	*試料7	試料8	試料9
銅粉末	(g)	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
有機パインダ a ₁	(g)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		-
有機パインダa ₂	(g)	_	-	1	-	1	-	•	6.00	•
有機パインタ a ₃	(g)	1	-	1	-	-	-	-	+	6.00
モノマー	(g)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
光ラシ カル発生剤 a	(g)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
光ラシ カル発生剤 b	(g)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
分散剤 a ₁	(g)	0.11	1	1	-	_	-	+	0.11	0.11
分散剤 a2	(g)	1	0.11	-	-	1	-	-	-	-
分散剤 a3	(g)	_	_	0.11	-	-	-		-	_
分散剤 a4	(g)	-	-	-	0.11	1	-	-	-	-
分散剤 a5	(g)		-	-	-	0.11	1	1	-	-
分散剤 b	(g)	-		_	-	ı	0.11	1	ı	-
分散剤 c	(g)	-	-	-	-	_		0.11	-	
有機溶剤 a	(g)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
有機溶剤 b	(g)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
多価アルコール	(g)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
紫外線吸収剤	(g)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
チクソトロヒ [®] ック剤	(g)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
かラス粉末	(g)	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
残渣パターン率		1/100	1/100	1/100	88/100	90/100	100/100	100/100	1/100	1/62
欠けパターン率		0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	30/62

*印は本発明の請求範囲外

[0052]

【表2】

		*試料10	*試料11	試料12	試料13	試料14	試料15	*試料16
銅粉末	(g)	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
有機バインダa₁	(g)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
有機パインダ a2	(g)	-	-	1	_	ı	-	_
有機パインダ а3	(g)	-	-	1	-	1	-	-
モノマー	(g)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
光ラシカル発生剤 a	(g)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
光ラジカル発生剤 b	(g)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
分散剤 a ₁	(g)	-	0.033	0.055	0.33	0.55	0.88	0.99
分散剤 a2	(g)	~	_	-	-	-	-	_
分散剤 a3	(g)	_	-		_	-	_	_
分散剤 a4	(g)	-	-		-		-	
分散剤 a ₅	(g)	-	_		-	-	-	-
分散剤 b	(g)	_	-	_	-	-		-
分散剤 c	(g)		-	_	-	-		
有機溶剤 a	(g)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
有機溶剤 b	(g)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
多価アルコール	(g)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
紫外線吸収剤	(g)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
チクソトロピック剤	(g)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
ガラス粉末	(g)	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
残渣パターン率		100/100	65/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100
欠けパターン率		0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	30/100

*印は本発明の請求範囲外

[0053]

表1、表2からわかるように、ポリカルボン酸系分散剤が含有されている試料 1~5では、残渣パターン率が1%となっているのに対して、ポリカルボン酸系分散剤が含有されていない試料6,7,10では、残渣パターン率が100%となっている。

[0054]

また、表1からわかるように、分子量1500以下のポリカルボン酸系分散剤が含有されている試料1~3では、残渣パターン率が1%となっているのに対して、分子量1500を超えるポリカルボン酸系分散剤が含有されている試料4,5では、残渣パターン率がそれぞれ88、90%となっている。

[0055]

また、表1からわかるように、分子量10000以上の有機バインダが含有されている試料1,8では、残渣パターン率が1%となっているのに対して、分子量10000未満の有機バインダa3が含有されている試料9では、残渣パターン率は良好なものの、現像時に38列の銅パターンが流出してしまっており、流出していないパターンでも30列の銅パターンでパターンの一部欠落が認められる。

[0056]

また、表2からわかるように、ポリカルボン酸系分散剤が銅粉末100重量部に対して0.05~0.8重量部含有されている試料12~15では、残渣パターン率、欠けパターン率がそれぞれ1%、0%となっているのに対して、0.05重量部未満の試料11では残渣パターンが65%に、0.8重量部を超えた試料16では、欠けパターン率が30%となっている。

[0057]

【発明の効果】

本発明に係る光反応性樹脂組成物によれば、ポリカルボン酸系分散剤の作用により、卑金属粉末の凝集を抑制し、現像残渣を防止することができる。したがって、安定して微細かつ厚膜の導体パターンを形成することができる。

[0058]

また、本発明に係る光反応樹脂組成物を用いて導体パターンを形成することにより、高密度化、信号高速化に対応できる回路基板やセラミック多層基板を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施形態2における回路基板の製造方法を示す工程断面図である。

図2

実施形態3における回路基板の製造方法を示す工程断面図である。

【図3】

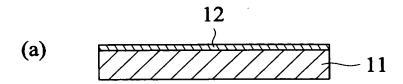
実施形態4におけるセラミック多層基板の製造方法を示す工程断面図である。

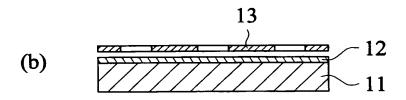
【符号の説明】

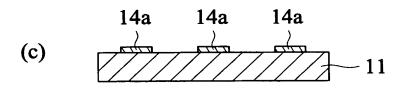
1 0	回路基板
1 1	基板
1 2	光反応性樹脂組成物
1 4 a	導体パターン
2 5	支持体
3 0	セラミック多層基板
3 0 a	積層体
3 6 a	セラミックグリーンシート

【書類名】 図面

【図1】

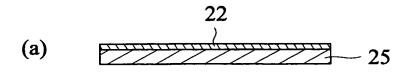


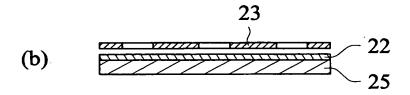


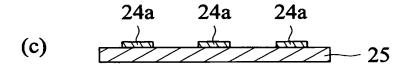


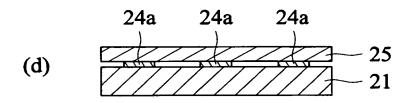
(d)
$$\frac{10}{14}$$
 14 14 14 11

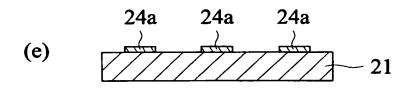
【図2】

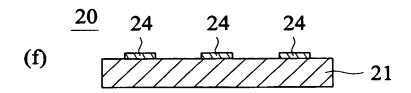




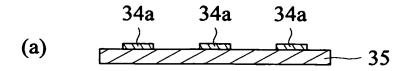


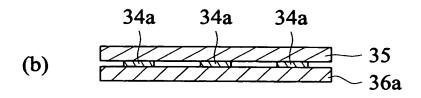


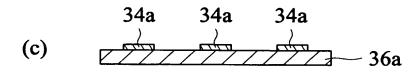


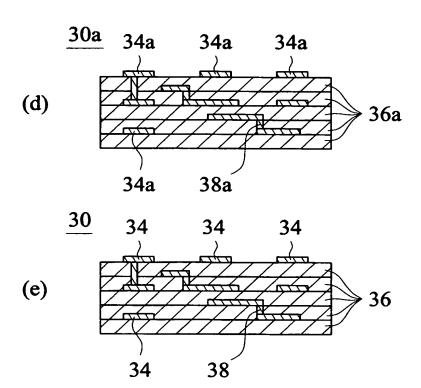


【図3】









【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 卑金属粉末の凝集が起こりにくい光反応性樹脂組成物を提供する

【解決手段】 (a) 卑金属粉末、(b) 有機バインダ、(c) 感光性有機成分、(d) 分子量が1500以下のポリカルボン酸系分散剤、を含有する光反応性樹脂組成物を作製する。

【選択図】 なし

【書類名】 手続補正書 【整理番号】 1150119

 【提出日】
 平成15年10月17日

 【あて先】
 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003- 33856

【補正をする者】

【識別番号】 000006231

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代表者】 村田 泰隆

【補正により増加する請求項の数】 1

【手続補正1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 特許請求の範囲

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

- (a) 卑金属粉末、
- (b) 有機バインダ、
- (c) 感光性有機成分、
- (d) 分子量が1500以下のポリカルボン酸系分散剤、

を含有することを特徴とする光反応性樹脂組成物。

【請求項2】 前記有機バインダの分子量が10000以上であることを特徴とする、請求項1に記載の光反応性樹脂組成物。

【請求項3】 前記卑金属粉末100重量部に対して、前記ポリカルボン酸系分散剤を0.05~0.8重量部含有することを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の光反応性樹脂組成物。

【<u>請求項4</u>】 <u>多価アルコールおよびチクソトロピック剤をさらに含有することを特徴とする、請求項1から請求項3のいずれかに記載の光反応性樹脂組成物。</u>

【請求項<u>5</u>】 請求項1から請求項<u>4</u>のいずれかに記載の光反応性樹脂組成物を用いて導体パターンを形成する工程を備えることを特徴とする回路基板の製造方法。

【請求項<u>6</u>】 請求項1から請求項<u>4</u>のいずれかに記載の光反応性樹脂組成物を支持体上に塗布する工程と、

前記光反応性樹脂組成物を露光、現像して前記支持体上に所定の導体パターンを形成する工程と、

前記支持体上に形成された前記導体パターンを基板上に転写する工程と、

前記導体パターンを焼成する工程と、

を備えることを特徴とする回路基板の製造方法。

【請求項<u>7</u>】 請求項1から請求項<u>4</u>のいずれかに記載の光反応性樹脂組成物を支持体上に塗布する工程と、

前記光反応性樹脂組成物を露光、現像して前記支持体上に所定の導体パターンを形成する工程と、

前記支持体上に形成された前記導体パターンをセラミックグリーンシート上に転写する 工程と、

前記導体パターンが転写されたセラミックグリーンシートを積層して積層体を形成する 工程と、

前記積層体を焼成する工程と、

を備えることを特徴とするセラミック多層基板の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0008

【補正方法】

変更

【補正の内容】

[0008]

前記光反応性樹脂組成物においては、前記有機バインダの分子量が10000以上であることが好ましい。また、前記光反応性樹脂組成物は、前記卑金属粉末100重量部に対して、前記ポリカルボン酸系分散剤を0.05~0.8重量部含有することが好ましい。 また、多価アルコールおよびチクソトロピック剤をさらに含有することが好ましい。

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005304

【納付金額】

2,000円

特願2003-033856

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名 株式会社村田製作所